⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願 公開

四公開特許公報(A)

昭62-286226

⑤Int Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)12月12日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/20

Z - 7376 - 5F7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 3 (全7頁)

②発明の名称 遠紫外線露光装置

> 创特 願 昭61-130586

図出 願 昭61(1986)6月5日

切発 明 者 尾 崎 治 厚木市森の里若宮3番1号 日本電信電話株式会社厚木電

気通信研究所内

の発 明 者 高 本 喜 厚木市森の里若宮3番1号 日本電信電話株式会社厚木電

気通信研究所内

眀 ②発 者 堀 $\dot{\Box}$ 緻 行 厚木市森の里若宮3番1号 日本電信電話株式会社厚木電

気通信研究所内

日本電信電話株式会社 ①出 顋 人 79代 理 人 弁理士 田中 正治

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

艄

1. 発明の名称

遠常外線露光装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 遠紫外線源から被露光体までの遠紫外線光 路の少なくとも一部に、上記道紫外線の透過 率を大気に比し小さな量しか低下させない気 体を存在させる手段を有することを特徴とす る遠常外線費光装置。
 - 2. 遠常外線源から被露光体までの遠常外線光 路の少なくとも一部に、上記遠常外線の透過 率を大気に比し小さな最しか低下させない気 体を存在させる手段と、

上記気体を流動させる手段とを有すること を特徴とする返常外線露光装置。

路の少なくとも一部に、上記遠紫外線の透過 率を大気に比し小さな量しか低下させない気 体を存在させる手段と、

上記気体を流動させる手段と、

上記気体の温度を制御する手段とを有する

ことを特徴とする選案外線電光装置。

- 4. 特許請求の範囲第1、第2または第3項記 載の選業外線舞光装置において、上記気体が、 窒素、二酸化炭素、ヘリウム、ネオン、アル ゴン、キセノン中から選ばれた1つの気体ま たは複数の気体の混合気体でなることを特徴 とする遠常外線露光装置。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、半導体集層回路などを製造する場 合に用いる遠紫外線舞光装置に関する。

従来の技術

従来、種々の遠常外線露光装置が提案されて

選索外線器光装置は、それに用いる選案外線 が常外線に比し短い波長を有するので、常外線 背光体上に、露光させることができるという特 改を有する。

<u>発明が解決しようとする問題点</u>

しかしながら、従来の選案外線器光装置は、

選素外額額から被請光体までの選素外線光路に、 その全長に亘って大気を存在させる構成を有し ているのを普通としていた。

また、従来の返案外線器光装置は、適常外線源から設露光体までの返案外線光路における光学系などが、通常外線源の照射を受けて発熱し、その結果、それら光学系などの機械的精度が大

遠索外線の透過率を大気に比し小さな量しか低 下させない気体を存在させる手段を有するとと もに、その気体を流動させる手段を有する。

作用・効果

本 顕 第 1 番目の発明による 遠 紫外 線 露 光 装 園によれば、 使用時、 遠 紫外 線 源 から 被 露 光 体 までの 遠 紫外 線 光路の 少 なくとも 一部に、 遠 紫外 線 の 透 過 率 を 大 気 に 比 し 小 さ な 母 し か 低 下 さ せない 気体を 存在させる ことができる。

このため、使用時、道案外線源から被露光体までの道案外線光路の少なくとも一部に、道案外

きく低下し、よって、道案外線を、所期の微細な露光パターンで、被露光体上に露光させることができなくなるとともに、露光パターンにばらつきを生ぜしめるという欠点を有していた。

問題点を解決するための手段

よって、本発明は、上述した欠点のない新規な遺業外線選光装置を提案せんとするものである。

本原第1番目の発明による道案外線器光線線の発明による道案外線器が外線器が外線器が外線器が外線器が外線器が外線器が外線器が外線をでの過程を使用して、一般では、一般では、一般では、一般では、一般の気体を用いる。

また、本願第2番目の発明による遠常外線器 光装置は、本願第1番目の発明による遺常外線 電光装置の場合と同様の、遠常外線源から被器 光体までの遠常外線光路の少なくとも一部に、

線の透過率を大気に比し小さな量しか低下させ ない気体を存在させることによって、選索外線 頭から被露光体までの選案外線光路における、 遠常外線の透過率を大気に比し小さな風しか低 下させない気体を存在させている部において、 逗累外線の透過率を大気に比し小さな頭しか低 下させない気体が道案外線によって照射されて も、遠常外線の透過率が、殆んど低下しないか、 低下するとしても遠常外線源から被嚣光体まで の遠常外線光路に大気を存在させている場合に 比し、小さな量でしか低下しないので、遠案外 線を、運業外線頭から波霧光体までの選案外線 光路に大気を存在させている場合に比し、高い 強度で、効率良く、囂光させることができる。 また、選素外線の透過率を大気に比し小さな量 しか低下させない気体として、窒素、二般化炭 深、ヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノン中 から遊ばれた1つの気体または複数の気体の混 合気体を用いる場合、その道常外線の透過率を 大気に比し小さな量しか低下させない気はが破

素を含んでいないので、遠紫外線源から被露光体までの遠紫外線光路における光学系の支持部材などが金属を用いて構成されていても、それらを酸化変質させることがなく、従って、遠紫外線露光装置を長期に直り使用することができる。

また、使用時、遠常外線源から被露光体までの遠常外線光路の少なくとも一部に、遠常外線のの透過率を大気に比し小さな量しか低下させない気体を存在させて、そして、その気体を、流動させることができる。このため、使用時、遠

第2番目の発明による道法外線露光装置の場合 と同様の作用・効果が得られる。

また、使用時、選索外線源から被露光体まで の遠常外線光路の少なくとも一部に、遠常外線 の透過率を大気に比し小さな量しか低下させな い気体を存在させ、そしてその気体を温度制御 して流動させることができる。このため、違案 外線源から被露光体までの速素外線光路の少な くとも一部に、選案外線の透過率を大気に比し、 小さな量しか低下させない気体を存在させ、そ して、その気体を流動させ、しかも、その気体 の温度を、低い温度に、制御することによって、 遠常外線源から被露光体までの演案外線光路に おける光学系などが遠常外線の照射を受けて発 熱しても、その熱を、道常外線の透過率を大気 に比し小さな量しか低下させない気体を介して、 本類第2番目の発明による選素外線器光装置の 場合に比し、より効果的に放散させることがで きるとともに、選索外類の透過率を大気に比し 小さな量しか低下させない気体の温度を、光学

さらに、本願第3番目の発明による選案外線 露光装置によれば、本願第2番目の発明による選案外線 露案外線環光装置の場合と同様に、使用時の 案外線源から被露光体までの選案外線があると なくとも一部に、選案外線の透過率を大きませる し小さな量しか低下させない気体を存在される その気体を流動させることができるの

系などが常時一定の温度を保つように制御することによって、選案外線を、所期の微細な露光パターンで、しかもその露光パターンにはらつきを生ぜしめることなしに、波露光体上に露光させることができる。

実施例

次に、第1図を伴なって本発明による遠常外線電光装置の実施例を述べよう。

 有する。

しかしながら、本発明による遺紫外線器光装 置の一例は、このような構成を有する道業外線 露光装置において、波露光体2を載置する移動 台3を設置する基体21と、その基体21と共 動して、照射光学系9、露光パターン描写体5 及び照射光学系11を配している遠常外線光路 4 の大部分を移動台3 とともに包囲している筒 体22と、その簡体22と遠紫外線源1との簡 の選索外線光路4の残却を、それら簡体22及 び遠紫外線源1と遅通して、包囲している管体 23と、遠常外線の透過率を大気に比し小さな 量しか低下させない気体を得ることができる気 体源24と、その気体源24からの違案外線の 透過率を大気に比し小さな量しか低下させない 気体の温度を制御する温度制御装置25と、そ の温度制御装置25から得られる温度制御され た遺業外線の透過率を大気に比し小さな量しか 低下させない気体を、類体22内に供給する気 体供給管26と、その気体供給管26を介して

節体22に供給される、速紫外線の透過率を大気に比し小さな近しか低下させない気体を、節体22内で、照射光学系9、露光パターン描写体5及び投影光学系11に対して流動させるための排気管27とを有する。

以上が、本発明による選案外線露光装置の実施例の構成である。

このような構成を有する本発明による道案外線器光装置によれば、従来の道案外線速光装置の場合と同様に、道案外線源1からの道案外線を、被器光体2に、照射光学系9及び役形光学系11を介して、露光パターンに応じた露光パターンに応じた露光パターとは明らかであることができることは明らかである。

しかしながら、第1回に示す本発明による遠 常外線露光装置によれば、基体21と、荷達2 2と、管体23とからなる構成によって、選出外線源1から被電光体2までの遠常外線光路4 に、その全長に亘って遠常外線の透過率を存在さ に比し小さな量しが低下させない気体を存在さ せる手段を構成している。

また、気体源24と、気体供給管26と、非

気管27とからなる偶成によって、 選索外線系 1から披露光体2までの選索外線光路4に存在させられる選索外線の透過率を大気に比し小さな 量しか低下させない気体を流動させる手段を 構成している。

さらに、温度制御装置25によって、遠葉外線が1から披露光体2までの遠常外線光路4に存在させられる遠紫外線の透過率を大気に比し小さな最しか低下させない気体の温度を制御する手段を構成している。

するとしても、 選案外線 源 1 から被露光体 2 までの 選案外線 光路 4 に大気を存在させている場合に比し、小さな量でしか低下しない。

因みに、遠常外線源1から被露光体2までの 選案外線光路4における選案外線の透過率が、 被露光体2上の遠紫外線の規格化された強度で みて、遠常外線源1から波露光体2までの遠常 外線光路4に、その全長に亘って、本発明によ らずに、従来の場合と同様に、大気を存在させ た場合、道紫外線源1をAFFエキシマレーザ とし、そして、その遺焦外線源1からの遠紫外 線として、193nmの波長を有し且つ50P PSのパルス波でなるArレーザ光を用いたと き、及び選案外線源1をKFFエキシマレーザ とし、その選素外線源1からの選素外線として、 249 n m の 波 長 を 有 し 且 つ 5 0 P P S の パ ル ス波でなるKFFレーザ光を用いたときで、そ れぞれ第2図及び第3図中曲線に示すように大 きく低下する結果が得られるとき、遮索外線源 1から被露光体2までの道案外線光路4に、そ

などが、金属を用いて構成されていても、それらを酸化変質させることがなく、従って、選業 外線露光装置を長期に亘り使用することができ

また、第1回に示す本発明による選案外線器 光装置によれば、上述した遺常外線の透過率を 大気に比し小さな量しか低下させない気体を流 動させる手段によって、道案外線の透過率を大 気に比し小さな量しか低下させない気体を流動 させることができるので、遠常外線源1から被 露光体2までの遠紫外線光路4における、照射 光学系9、露光パターン描写体5及び投影光学 系11などが、道案外線の照射を受けて発熱し ても、その熱を、遺常外線の透過率を大気に比 し小さな量しか低下させない気体を介して、外 部に放散させることができる。因みに、遠常外 敬の透過率を大気に比し小さな 量しか 低下させ ない気体として窒素を用いたとき、照射光学系 11の温度が、その窒素でなる遠常外線の透過 率を大気に比し小さな母しか 低下させない 気体 の全長に亘って、本発明による、選案外線の返 過率を大気に比しいな配しか低下させるに比しなな配しので条件とした。 体を存在させることを除いて同じ条件としたに場合、上述したと同じAFFレーザ光を用いたと き、及び上述したと同じKFFレーザを用いたと きで、第2図及び第3回中の曲線に示ったと ときで、第2回及びいた。 ともで、発んど低下しないには はした。

従って、速常外線を、返常外線原1から被露 光体2までの選常外線光路4に、大気を存在させている場合に比し、高い強度で、効率良く、 電光させることができる。

従って、照射光学系9、露光パターン個写体 5及び投影光学系11などの機械的精度を熱によって大きく低下させることがなく、よって、 選累外線を、所則の数細なパターンで、被露光 体2上に露光させることができなくなることが ない。

さらに、第1回に示す本発明による選累外線器光装置によれば、上述した選案外線の透過率を大気に比し小さな量しか低下させない気体の温度を制御する手段によって、選案外線の透過率を大気に比し小さな量しか低下させない気体の温度を、低い温度に制御することができるの

なお、上述においては、遠常外線源1から被 露光休2までの選常外線光路4に、その全長に 亘って、遠常外線の透過率を大気に比し小さな 最しか低下させない気体を存在させる構成にし た場合について述べたが、例えば還常外線光路

省略している構成にすることもでき、その他、 本発明の精神を脱することなしに、種々の変型、 変更をなし得るであろう。

4、 図面の簡単な説明

第 1 図は、本発明による遠常外線露光装置の 実施例を示す略線的断面図である。

第2 図及び第3 図は、遠紫外線源から波露光体までの選紫外線光路における、遠紫外線の透過率の変化を、遠紫外線の被露光体上の強度の変化で示す曲線図である。

第4図は、 道常外線源から被電光体までの 道 常外線光路における光学系の温度の変化を示す 曲線図である。

- 1 --- --- 道 常 外 糗 源
- 2 … … 被舞光体
- 3 … … 一移動台
- 5 … … … 露 光 パ タ ー ン 描 写 体
- 9 … … 照射光学系
- 1 1 … … 投影光学系

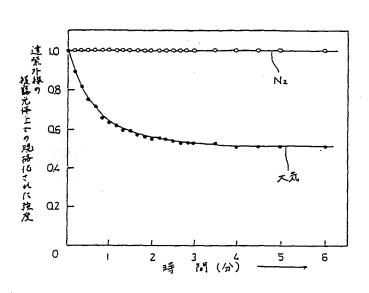
4 の 選 紫 外 線 源 1 及 び 照 射 光 学 系 9 間 の 部 が 比 校的短い場合、哲体23を省略したり、管体3 を省略するとともに照射光学系9及び露光パタ ーン描写体5の一面を簡体22外に在らしめた 構成にしたり、投影光学系11の罰体32内に 遺素外線の透過率を大気に比し小さな最しか低 下させない気体を導入させない構成にしたりす ることによって、 遠常外線源1から波露光体2 までの遠常外線光路4の一部だけに、遠常外線 の透過率を大気に比し小さな最しか低下させな い気体を存在させる構成とすることもでき、ま た、排気管27を省略することによって、箇体 2.2内に選紫外線の透過率を大気に比し小さな **最しか低下させない気体を導入させる構成には** するが、選案外線の透過率を大気に比し小さな **量しか低下させない気体を流動させる手段を省** 略している構成にすることもでき、さらに、温 度制御装置25を省略することによって、遠常 外線の照射による透過率を大気に比し小さな最 しか低下させない気体の温度を制御する手段を

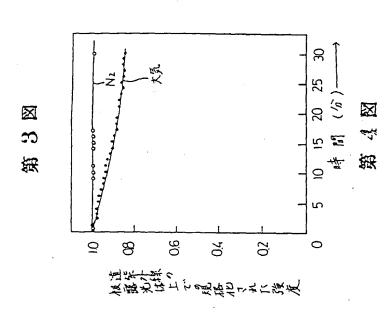
- 2 1 巫 体
- 2 2 … … 面体
- 2 3 --- --- 管体
- 2 5 … … 温度制御装置
- 2 7 … … 排 気 管

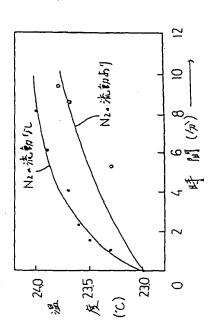
出願人 日本電信電話株式会社

代理人 弁理士 田 中 正 治

第 2 図







					•
			241		
	,				
, .				* ;	
		g.			
e ^s					

Japanese Patent Laid-open No. 62-286226

Embodiment

5

10

15

20

25

(p.123-p.124)

Similar to conventional far ultraviolet exposure apparatus, a far ultraviolet exposure apparatus related to the present invention comprises: a far ultraviolet source 1 using sources such as an excimer laser, a deuterium lamp, a xenon lamp, or a mercury lamp; an XY moving mount 3 on which an exposure subject 2 such as a semiconductor wafer is mounted; an exposure pattern formed body 5 which is arranged in a far ultraviolet optical path 4 from far ultraviolet source 1 to exposure subject 2; an irradiation optical system 9 made up of parts such as a reflection mirror 6, a diffusion mirror 7, or a irradiation lens 8 that are arranged in between far ultraviolet source 1 and exposure pattern formed body 5; and a projection optical system 11 made up of a projection lens 10 or the like arranged in between exposure pattern formed body 5 and exposure subject 2, as is shown in Fig. 1.

With a far ultraviolet exposure apparatus having such a structure, an example of a far ultraviolet exposure apparatus related to the present invention also has: a base 21 on which moving mount 3 where exposure subject 2 is mounted is placed; a housing 22 which encloses along with base 21 and moving mount 3 a large part of far ultraviolet optical path 4 where irradiation optical system 9, exposure pattern formed body 5, and irradiation optical system 11 are arranged; a piping body 23 enclosing the remaining part of far ultraviolet optical path

4, in connection with housing 22 and far ultraviolet source 1; a gas source 24 capable of supplying gas that reduces transmittance of far ultraviolet light only by a small amount compared with atmosphere; a temperature control unit 25 for controlling the temperature of the gas supplied from gas source 24 that reduces transmittance of far ultraviolet light only by a small amount compared with atmosphere; a gas supply piping 26 for supplying gas obtained from temperature control unit 25, which is a temperature controlled gas that reduces transmittance of far ultraviolet light only by a small amount compared with atmosphere, to housing 22; and an exhaust piping 27 for creating a flow of gas supplied via gas supply piping 26 that reduces transmittance of far ultraviolet light only by a small amount compared with atmosphere inside housing 22, from irradiation optical system 9 to exposure pattern formed body 5 and projection optical system 11.

5

10

15

20

25

In this case, housing 22 supports exposure pattern formed body 5 in a manner dividing housing 22 into two; irradiation optical system 9 side 30 and projection optical system 11 side 31. Housing 22 also supports projection optical system 11 via a housing 32 in a manner dividing projection optical system 11 side 31 into two; exposure pattern formed body 5 side 33 and exposure subject 2 side 34. In addition, corresponding to this arrangement, gas supply piping 26 is made up of piping 40 which extends into side 30 of housing 22, piping 43 and 44 which extend into side 33 and side 34, respectively, of housing 22, and piping 45 which extends into housing 32 of projection optical system 11. Furthermore, exhaust piping 27

is made up of piping 50, which extends outside from side 30 of housing 22, piping 53 and 54 which extend outside from side 33 and side 34, respectively, of housing 22, and piping 55 which extends outside from housing 32 of projection optical system 11.

٠ - -